


	<p>SQJ416EP-T1_GE3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SQJ416EP-T1_GE3</p>
	<p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 27A SO8</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Datenblätter:  SQJ416EP-T1_GE3.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>









Spezifikationen

Teilenummer	SQJ416EP-T1_GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 27A SO8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	Automotive, AEC-Q101, TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	30 mOhm @ 10A, 10V
Verlustleistung (max)	45W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	800pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	27A (Tc)

SQJ416EP-T1_GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SQJ416EP-T1_GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SQJ416EP-T1_GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SQJ416EP-T1_GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SQJ422EP-T1_GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 75A PPAK SO-8</p>	 <p>SQJ418EP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 48A POWERPAKSO</p>	 <p>SQJ412EP-T1_GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 32A PPAK SO-8</p>	 <p>SQJ412EP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 32A PPAK SO-8</p>
 <p>SQJ414EP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 30A POWERPAKSOL</p>	 <p>SQJ422EP-T1-GE3 VISHAY VISHAY POWERPA</p>	 <p>SQJ415EP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CHAN 40V POWERPAK SO-8L</p>	 <p>SQJ418EP-T1_GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 100V 48A SO8</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SQJ416EP-T1_GE3 Vishay / Siliconix	SQJ416EP-T1_GE3 Datenblatt	SQJ416EP-T1_GE3-Datenblätter	SQJ416EP-T1_GE3 PDF	Vishay / Siliconix SQJ416EP-T1_GE3
SQJ416EP-T1_GE3 Electronic	SQJ416EP-T1_GE3-Komponenten	SQJ416EP-T1_GE3-Verteiler	SQJ416EP-T1_GE3-Bild	SQJ416EP-T1_GE3-Teil
SQJ416EP-T1_GE3 Preis	SQJ416EP-T1_GE3 Hersteller	SQJ416EP-T1_GE3 Bild	SQJ416EP-T1_GE3 Aktie	SQJ416EP-T1_GE3 Inventar
SQJ416EP-T1_GE3 Neu	SQJ416EP-T1_GE3 Original	SQJ416EP-T1_GE3 garantiert	SQJ416EP-T1_GE3 RFQ	SQJ416EP-T1_GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited